

# Paniers De Nettoyage De Wafers En Ptfé Personnalisés Porte-Wafers En Silicium Semi-Conducteurs Cassettes En Fluoropolymère À Faible Bruit De Fond

Numéro d'article: PL-CP266



## Introduction

Paniers de nettoyage de wafers en PTFE personnalisés de haute pureté pour le traitement semi-conducteur. Conçus pour l'analyse de traces à faible bruit de fond et offrant une résistance chimique élevée, ces cassettes sur mesure en fluoropolymère garantissent aucune dissolution et une manipulation sans contamination des wafers en silicium dans des environnements de salle blanche critiques et des laboratoires industriels.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
<b>Nettoyage RCA (SC-1/SC-2)</b>	Élimination des contaminants organiques, des couches d'oxyde minces et des impuretés ioniques des surfaces en silicium.	Haute résistance aux mélanges de peroxyde d'hydrogène et d'hydroxyde d'ammonium.
<b>Gravure à l'acide fluorhydrique</b>	Élimination sélective des couches de dioxyde de silicium et passivation de surface.	Immunité complète au HF, qui dégraderait autrement les porte-wafers en quartz ou en verre.
<b>Traitement de gravure Piranha</b>	Élimination agressive des résidus organiques lourds et de la photorésine à l'aide d'acide sulfurique et de peroxyde.	Maintient l'intégrité structurelle dans des environnements fortement exothermiques et oxydants.
<b>Support pour la photolithographie</b>	Manipulation des wafers pendant le développement, le décollement et le rinçage des matériaux de photorésine.	La résistance aux solvants garantit que le porte-wafer ne gonfle pas ni ne ramollit lorsqu'il est exposé aux décolleurs.
<b>Rinçage post-CMP</b>	Nettoyage critique des wafers après planarisation chimico-mécanique pour éliminer les boues abrasives.	La surface à faible génération de particules garantit que les wafers restent propres après l'étape de polissage.
<b>Préparation de semi-conducteurs composés</b>	Nettoyage spécialisé des wafers GaAs, GaN et InP pour l'optoélectronique avancée.	Le support doux à fentes précises évite d'endommager les matériaux composés fragiles.
<b>Nettoyage par ultrasons/mégasons</b>	Nettoyage par vibration à haute fréquence pour déloger les particules submicroniques dans l'eau déionisée.	Les propriétés du matériau amortissent les vibrations excessives tout en permettant un transfert d'énergie efficace.

Catégorie de paramètre	Détail de spécification pour PL-CP266
<b>Matériau principal</b>	PTFE (Polytétrafluoroéthylène) / PFA (Perfluoroalcoxy) de haute pureté
<b>Méthode de fabrication</b>	Usinage CNC de haute précision (Fabrication sur mesure)
<b>Compatibilité de taille de wafer</b>	Entièrement personnalisable (Tailles courantes : 2", 3", 4", 6", 8", 12" ou dimensions sur mesure)
<b>Configuration des fentes</b>	Espacement, profondeur et quantité personnalisés selon les exigences du procédé
<b>Conception de la poignée</b>	Poignées fixes, amovibles ou œillets de levage intégrés disponibles (Personnalisable)

Application	Description	Avantage clé
Catégorie de paramètre	Détail de spécification pour PL-CP266	
Résistance chimique	Excellente (Compatible avec tous les acides, bases et solvants organiques)	
Plage de température de fonctionnement	-200°C à +260°C (Limite du matériau ; spécifique à l'application)	
Rugosité de surface	Finition CNC contrôlée pour un piégeage minimal de particules	
Bruit de fond en éléments traces	Optimisé pour l'analyse de traces à bas niveau (□□□□□ )	
Profil de dissolution	Aucune dissolution / Aucun additif lessivable (□□ )	